

Misura della caratteristica I-V di due diodi a giunzione p-n

Cristina Caprioglio, Luca Morelli

Primo turno, tavolo 3

Abstract

Lo mettiamo? Lei non lo menziona

1 Scopo della prova

La prova consisteva nella misura delle caratteristiche I-V di due diodi a giunzione p-n, uno al silicio e uno al germanio. Si sono inoltre realizzati dei fit su ROOT in modo da ricavare i parametri fisici corrente inversa " I_0 " e " ηV_T ", rispettivamente la corrente inversa e il prodotto tra il fattore di idealità e l'equivalente della temperatura in volt.

2 Procedura

3 Materiali utilizzati

4 Strumentazione

5 Misurazioni

5.1 Calibrazione dell'oscilloscopio

5.2 Silicio

5.3 Germanio

6 Grafici

6.1 Calibrazione dell'oscilloscopio

6.2 Silicio

6.3 Germanio

Conclusioni